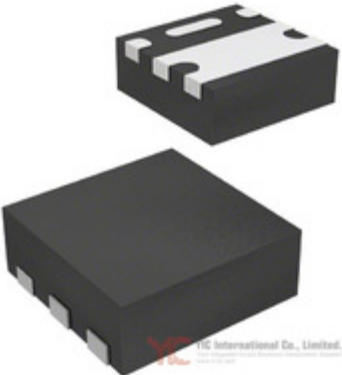

	<p>SIA418DJ-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA418DJ-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 12A SC70-6</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SIA418DJ-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 43 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>




Spezifikationen

Teilenummer	SIA418DJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	43 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 9A, 10V
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Andere Namen	SIA418DJ-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	570pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 12A (Tc) 3.5W (Ta), 19W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SIA418DJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA418DJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA418DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA418DJ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIA421DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA418DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA419DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA421DJ-T1-E3 VISHAY VISHAY QFN-6</p>
 <p>SIA416DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 11.3A SC70-6L</p>	 <p>SIA419DJ VISHAY SIA419DJ VISHAY</p>	 <p>SIA419DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA416DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 11.3A SC70-6L</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA418DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / SIA418DJ-T1-GE3 Datenblatt Vishay	SIA418DJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA418DJ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIA418DJ-T1-GE3
SIA418DJ-T1-GE3 Electronic	SIA418DJ-T1-GE3-Komponenten	SIA418DJ-T1-GE3-Bild	SIA418DJ-T1-GE3-Teil
SIA418DJ-T1-GE3 Preis	SIA418DJ-T1-GE3 Hersteller	SIA418DJ-T1-GE3 Bild	SIA418DJ-T1-GE3 Inventar
SIA418DJ-T1-GE3 Neu	SIA418DJ-T1-GE3 Original	SIA418DJ-T1-GE3 garantiert	SIA418DJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited